EN 旌芯 Semiconductor

旌芯半导体科技(上海)有限公司

GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN1616

1、概述

GN1616是LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器等电路。本产品主要应用于VCR、VCD、DVD及家庭影院等产品的显示屏驱动。

主要特点

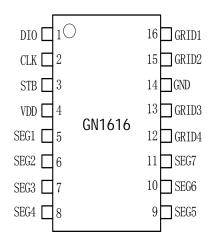
- ·采用CMOS工艺
- ·显示模式(7段×4位)
- · 辉度调节电路(占空比8级可调)
- ·串行接口(CLK, STB, DIO)
- · 内置RC振荡 (450KHz ± 5%)
- · 内置上电复位电路

封装形式

GN1616 SOP16 50PCS/管 10000PCS/盒 100000PCS/箱(塑封体尺寸:10mm×3.9mm引脚间距:1.27mm)
GN1616 SOP16 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱(塑封体尺寸:10mm×3.9mm引脚间距:1.27mm)

2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图



2.2、引脚说明

引脚	引脚名称	符号	说明
1	数据输入/输出	DIO	在时钟下升沿输入/输出串行数据,从低位开始。 输出为 N-ch open drain,且内部集成上拉电阻 20K 左 右。
2	时钟输入	CLK	在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据。
3	片选	STB	在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理被终止。当 STB 为高时,CLK 被 忽略。
4	逻辑电源	VDD	电源电压
5	输出(段)	SEG1	段输出,P管开漏输出。
6	输出(段)	SEG2	段输出,P管开漏输出。



GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN1616

-			
7	输出(段)	SEG3	段输出,P管开漏输出。
8	输出(段)	SEG4	段输出,P管开漏输出。
9	输出(段)	SEG5	段输出,P管开漏输出。
10	输出(段)	SEG6	段输出,P管开漏输出。
11	输出(段)	SEG7	段输出,P管开漏输出。
12	输出(位)	GRID4	位输出,N管开漏输出。
13	输出(位)	GRID3	位输出,N管开漏输出。
14	逻辑地	GND	接系统地
15	输出(位)	GRID2	位输出,N管开漏输出。
16	输出(位)	GRID1	位输出,N管开漏输出。

3、电特性

3.1、极限参数(GND = 0V, Tamb=25)

参数名称	符号	条件	额 定 值	单 位
逻辑电源电压	V_{DD}	-	- 0.5∼+7.0	V
逻辑输入电压	V_{I1}	-	$-0.5 \sim V_{DD} + 0.5$	V
LED Seg 驱动输出电流	I_{O1}	=	-50	mA
LED Grid 驱动输出电流	I_{O2}	-	+200	mA
功率损耗	P_{D}	-	400	mW
工作温度	Topt	-	- 40~+80	$^{\circ}$ C
储存温度	Tstg	-	-65∼+150	$^{\circ}$
焊接温度	$T_{\rm L}$	10 秒	250	$^{\circ}$ C

3.2、推荐使用条件(Ta= -20 ~+70 , GND=0V)

参数名称	符号	最小	典型	最大	单 位
逻辑电源电压	V_{DD}	3	5	5.5	V
高电平输入电压	$V_{ m IH}$	$0.7V_{DD}$	-	$ m V_{DD}$	V
低电平输入电压	V_{IL}	0	-	$0.3V_{DD}$	V

3.3、电气特性

3.3.1、电气特性(Ta= -20 ~+70 , VDD=4.5V~5.5V ,GND=0V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
高电平输出电流	I_{OH1}	Seg1 \sim Seg7, V_O = V_{DD} -2 V	-20	-25	-40	mA
	I_{OH2}	Seg1 \sim Seg7, V_O = V_{DD} -3 V	-20	-30	-50	mA
低电平输出电流	I_{OL1}	$Grid1 \sim Grid4, V_O = 0.3V$	80	140	-	mA
低电平输出电流	I_{DATA}	$V_O=0.4V$, DIO	4	8	-	mA
高电平输出电流 容许量	I _{TOLSG}	$V_O=V_{DD}-3V$, Seg1 \sim Seg7	-	-	5	%
输入电流	I_{I}	$V_I = V_{DD}/GND$	-	-	±1	uA
高电平输入电压	V_{IH}	CLK、DIO、STB	$0.7V_{DD}$	1		V
低电平输入电压	V_{IL}	CLK、DIO、STB	-	1	$0.3V_{\mathrm{DD}}$	V
滞后电压	V_{H}	CLK、DIO、STB	-	0.35	-	V
动态电流损耗	I_{DD} dyn	无负载,显示关	-	-	5	mA
输出下拉电阻	RL	K1~K2	-	10	-	$\mathbf{K} \Omega$



GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

3.3.2、开关特性(Ta= -20 ~+70 , VDD=4.5V~5.5V)

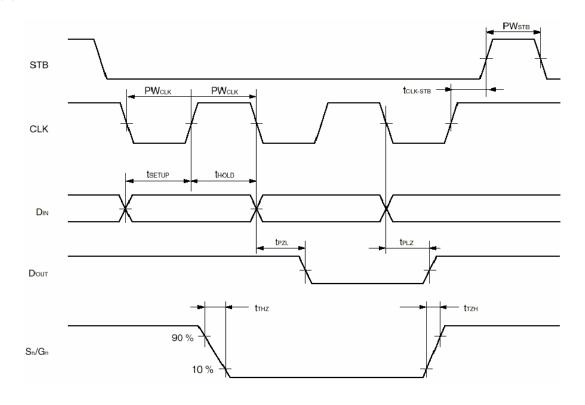
参数	符号	ž	则试条件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	f_{OSC}			-	450	1	KHz
传输延迟时间	$t_{\rm PLZ}$	C	LK→DIO	-	ı	300	ns
1女相及6人2月1月	t_{PZL}	CL=1:	5pF, R_L =10K Ω	-	-	100	ns
	T_{TZH1}		Seg1~Seg7	-	-	2	us
上升时间	T _{TZH2}	CL=300pF	Grid1∼Grid4	-	ı	0.5	us
下降时间	T_{THZ}	CL=300p	F、Segn、Gridn	-	ı	120	us
最大时钟频率	Fmax	占	空比 50%	1	1	ı	MHz
输入电容	C_{I}		-	-	-	15	pF

3.3.3、时序特性(Ta= -20 ~+70 , VDD=4.5V~5.5V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PWCLK	-	400	-	-	ns
选通脉冲宽度	PWSTB	•	1	-	-	μs
数据建立时间	t_{SETUP}	-	100	-	-	ns
数据保持时间	$t_{ m HOLD}$	1	100	-	-	ns
CLK→STB 时间	t _{CLK STB}	CLK↑→STB↑	1	-	-	μs
等待时间	t_{WAIT}	CLK↑→CLK↓	1	-	-	μs

4、时序图与端口操作说明、指令系统介绍

4.1、时序图



GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN1616

4.2、显示寄存器地址和显示模式

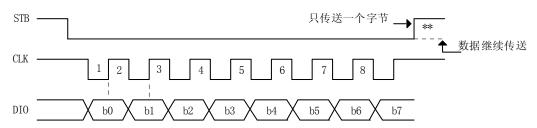
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到GN1616的数据,地址分配如下:

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
xxHI	上(低四	位)		xxHU	J(高四	位)		xxHI	上(低四	位)		xxHU	J(高匹	[位)		
В0	B1	B2	В3	B4	B5	B6	B7	В0	B1	B2	В3	B4	B5	В6	B7	
00HI	- 			JH00	J			01HI	_			01HU	J			GRID1
02HI	- 			02HU	J			03HI	_			03HU	J			GRID2
04HI				04HU	J			05HI	_			05HU	J			GRID3
06HI	J			06HU	J			07HL			07HU				GRID4	
08HI	- 			08HU	J			09HI	_			09HU	J			GRID5
0AH	L	•	•	0AH	U		•	0BH	L	•		0BH	U			GRID6
0CH	L			0CH	U			0DH	L			0DH	U			GRID7

4.3、串行数据传输格式

接收1个bit在时钟的上升沿操作。

· 数据接收(写数据)



4.4、指令介绍

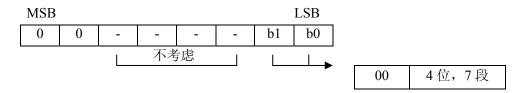
指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。 在STB下降沿后由DATA输入的第一个字节作为一条指令。

B7	В6	指令
0	0	显示模式设置
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

(1)显示模式设置

该指令用来设置选择段和位的个数。当指令执行时,显示被强制终止。要重新显示,显示开/关指令"ON"必需被执行,但当相同模式被设置时,则上述情况并不发生。

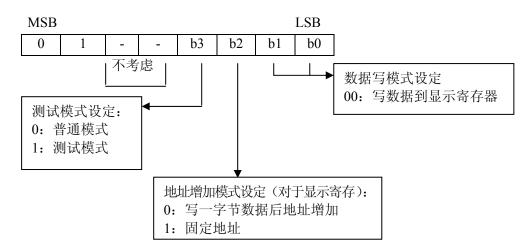




GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

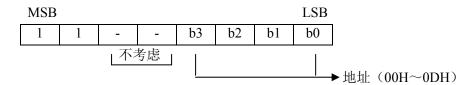
(2)数据设置

该指令用来设置数据写



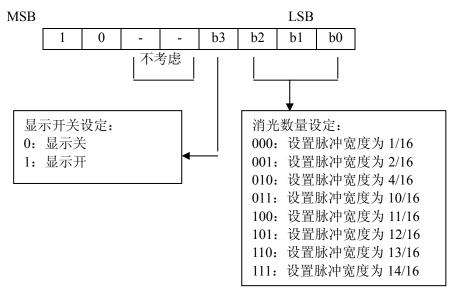
(3) 地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。



如果地址设为OEH或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。上电时,地址设为OOH。

(4)显示控制

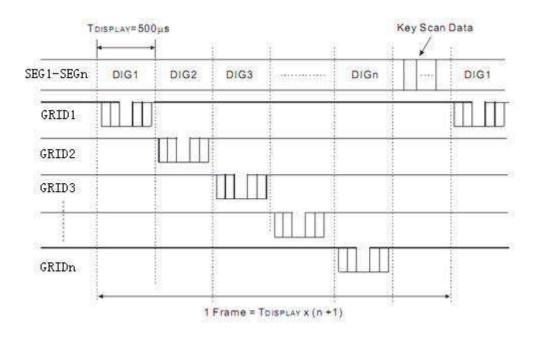


注: * 上电时,设置为脉冲宽度为1/16,显示关。

GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

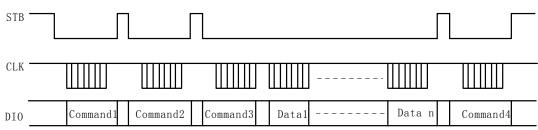
GN1616

4.5、显示周期



4.6、应用时串行数据的传输

· 地址增加模式



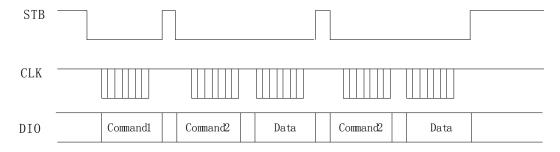
Command1:设置显示模式。显示模式的设置在上电后设置,一般只需要设置一次就可以了。

Command2:设置数据 Command3:设置地址

Data1~Data n:传输显示数据(最多14字节)

Command4:控制显示

固定地址

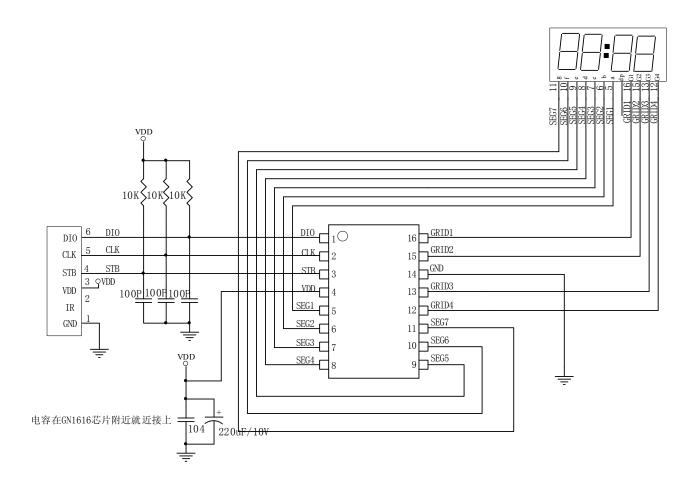


Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data:显示数据

http://www.gnsemic.com



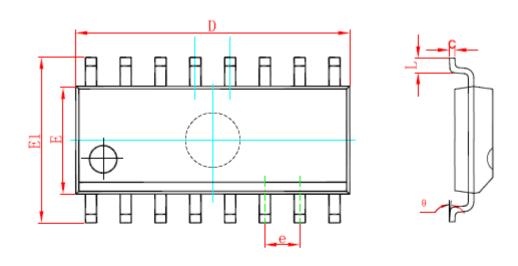
5、典型应用线路图

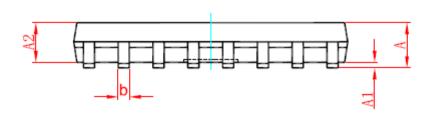




6、封装尺寸与外形图

6.1、SOP16外形图与封装尺寸





0 1 1	Dimensions I	n Millimeters	Dimensions In Inches			
Symbol	Min	Max	Min	Max		
Α	1. 350	1. 750	0. 053	0. 069		
A1	0. 100	0. 250	0.004	0. 010		
A2	1. 350	1.550	0.053	0. 061		
b	0. 330	0. 510	0.013	0. 020		
С	0. 170	0. 250	0.007	0. 010		
D	9. 800	10. 200	0. 386	0. 402		
E	3. 800	4. 000	0. 150	0. 157		
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244		
е	1. 270	(BSC)	0. 050	(BSC)		
L	0. 400	1. 270	0.016	0. 050		
θ	0°	8°	0°	8°		

第8页,共9页



GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN1616

7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部					有毒有	害物质	或元素			
件 名 称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (C d)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封树 脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明									检出限以下 的限量要求	-

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利 等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、 死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。 本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知,建 议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。